

COSEM

TRANSISTORS Si

DIODES UHF

**DIODES DE SIGNAL
DIODES DE COMMUTATION
DIODES DIVERSES**

CIRCUITS INTÉGRÉS

1968

TRANSISTORS Ge



Compagnie générale des Semi-conducteurs

S. A. AU CAPITAL DE 18 400 000 F - SIEGE SOCIAL - ST-EGREVE (ISERE) - R. C. N° 60 B 44 - GRENOBLE

SERVICES COMMERCIAUX 78, AVENUE MARCEAU - 75-PARIS (8^e) - TEL. 359 07-89

DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION_DIVERSES

DETECTION AND SWITCHING DIODES_MISCELLANEOUS

I DIODES GERMANIUM A POINTE TUNGSTÈNE

GERMANIUM TUNGSTEN DIODES

			Limites absolues Max. Ratings $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$		Caractéristiques générales General Characteristics			
USAGES USES	Type	Boîtier Case	V_R (V)	I_F (mA)	I_F min à $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ (mA)	I_R max (μA)		à t_{amb} ($^{\circ}\text{C}$)
H Usage Général General Purpose	1N 54 A	DO-7	50	30	5 (1 V)	7 (10 V)	100 (50 V)	25
	1N 81		40	30	3 (1 V)	10 (10 V)	100 (40 V)	25
	1N 198		80	30	4 (1 V)	75 (10 V)	250 (50 V)	75
	SF.D 108		100	50	5 (1 V)	7 (10 V)	250 (100 V)	25
Détection - Montage Discriminateur	AA 113	DO-7	60	25	3,5 (1 V)	120 (30 V)	500 (60 V)	25
	AA 119		45	35	4 (1 V)	60 (10 V)	500 (45 V)	60
	1N 541		45	35	4 (1 V)	60 (10 V)	500 (45 V)	60
	1N 542		45	35	4 (1 V)	60 (10 V)	500 (45 V)	60
Détection Vidéo Video Detection	SF.D 106	DO-7	25	30	5 (1 V)	10 (1,5 V)	200 (25 V)	25
H ▲ Commutation Switch	SF.D 105	DO-7	30	30	5 (1 V)	120 (10 V)	500 (30 V)	55
	1N 191		70	30	5 (1 V)	25 (10 V)	250 (70 V)	55
	1N 192		50	30	5 (1 V)	50 (10 V)	250 (50 V)	55
	FS.36		30	30	30 (2 V)	40 (10 V)	250 (30 V)	25

II DIODES GERMANIUM POINTE OR

GOLDBONDED GERMANIUM DIODES

			Limites absolues Max. Ratings $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$		Caractéristiques générales General Characteristics			
USAGES USES	Type	Boîtier Case	V_R (V)	I_F (mA)	I_F min à $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ (mA)	I_R max (μA)		à t_{amb} ($^{\circ}\text{C}$)
H ▲ Usage général General purpose	SF.D 108 A	DO-7	100	50	30 (1 V)	7 (10 V)	250 (100 V)	25
	1N 270		80	90	200 (1 V)		100 (50 V)	25
	1N 277		100	100	100 (1 V)	75 (10 V)	250 (50 V)	75
Commutation Switch	FS 19	DO-7	25	110	110 (1,1 V)	65 (10 V)	240 (25 V)	70
	SF.D 121		10	30	10 (0,8 V)	10 (1,5 V)	50 (10 V)	55
	SF.D 122		25	50	50 (0,8 V)	60 (15 V)	100 (25 V)	55
Commutation ultra-rapide Ultra-high speed Switch	SF.D 118 A (AA Y 48)	DO-7	10	50	10 (0,5 V)	10 (6 V)	100 (10 V)	25
	1N 995		10	30	10 (0,5 V)	10 (6 V)	100 (15 V)	25
Commutation fort courant High current Switch	SF.D 129 B (AA Y 49)	DO-7	40	200	200 (0,75 V)	75 (10 V)	200 (40 V)	70
	AAZ 18		20	180	10 (0,41 V)	15 (10 V)	50 (20 V)	25

H : Homologué C.C.T.

▲ : Contrôle Centralisé de Qualité (CCQ)

DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION - DIVERSES

DETECTION AND SWITCHING DIODES - MISCELLANEOUS

III DIODES PLANES SILICIUM SILICON PLANAR DIODES

A-USAGE GENERAL GENERAL PURPOSE

Type	Boîtier Case	V_{RM} (V)	I_R max (nA)	à V_R (V)	I_F min à $V_F = 1 V$ (mA)	C max à 0 V (pF)
BAY 17	DO-7	15	100	12	100	
BAY 18	DO-7	60	100	50	100	
BAY 19	DO-7	120	100	100	100	
BAY 44	DO-7	50	200	50	100 (1,1 V)	
BAY 45	DO-7	150	200	150	100 (1,1 V)	
1N 456	DO-7	30	25	25	40	
1N 457	DO-7	70	25	60	20	
1N 461	DO-7	30	500	25	15	6
1N 462	DO-7	70	500	60	5	8
1N 483 B	DO-7	80	25	60	100	
1N 484	DO-7	130	250	125	100 (1,1 V)	
1N 484 A	DO-7	130	25	125	100	
SF.D 180	DO-7	50	100	50	30 (1,15 V)	4 (moy)
SF.D 181	DO-7	150	100	150	30 (1,15 V)	

B-COMMUTATION RAPIDE HIGH SPEED SWITCHING

Type	Boîtier Case	V_{RM} (V)	I_R max (nA)	à V_R (V)	I_F min à $V_F = 1 V$ (mA)	C à 0 V max (pF)	t_{rr} max (ns)	à I_F (mA)
BAY 71	DO-7	50	100	35	20	2	2	10
SF.D 83	DO-7	30	200	10	10 (1,1 V)	4	4	10
SF.D 183	DO-7	70	200	40	10	4	4	10
▲ 1N 914	DO-7	100	25	20	10	4	4	10
▲ 1N 914 A	DO-7	100	25	20	20	4	4	10
▲ 1N 914 B	DO-7	100	25	20	100	4	4	10
▲ 1N 916	DO-7	100	25	20	10	2	4	10
▲ 1N 916 A	DO-7	100	25	20	20	2	4	10
▲ 1N 916 B	DO-7	100	25	20	30	2	4	10
1N 3063	DO-7	75	100	50	10 (0,85 V)	2	4	10
1N 3064	DO-7	75	100	50	10	2	4	10
1N 3069	DO-7	65	100	50	50	6	50	30
1N 3604	DO-7	75	50	50	50	2	2	10
SF.D 43	F-80	30	200	10	10 (1,1 V)	4	4	10
SF.D 143	F-80	70	200	40	10	4	4	10
1N 4148	F-80	100	25	20	10	4	4	10
1N 4149	F-80	100	25	20	10	2	4	10
1N 4151	F-80	75	50	50	50	2	2	10
1N 4154	F-80	35	100	25	30	4	2	10
1N 4446	F-80	100	25	20	20	4	4	10
1N 4447	F-80	100	25	20	20	2	4	10
1N 4448	F-80	100	25	20	100	4	4	10
1N 4449	F-80	100	25	20	30	2	4	10
1N 4454	F-80	75	100	50	10	2	2	10

▲ : Sous CCQ (Contrôle Centralisé de Qualité) en 1968.

ELEMENTS NOUVEAUX

DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION - DIVERSES

DETECTION AND SWITCHING DIODES - MISCELLANEOUS

C-COMMUTATION RAPIDE FORT COURANT

HIGH CURRENT HIGH SPEED SWITCHING

Type	Boîtier Case	V_{RM} (V)	$I_{R\ max}$ (nA)	V_R (V)	$I_F\ min\ à\ V_F = 1\ V$ (mA)	$C\ à\ 0\ V\ max$ (pF)	$t_{rr\ max}$ (ns)	I_F (mA)
SF.D 185	DO-7	50	100	30	100	2,5	10	200
1N 3600	DO-7	75	100	50	200	2,5	6	400
1N 4150	F-80	75	100	50	200	2,5	6	400

D-COMMUTATION ULTRA RAPIDE

ULTRA SPEED SWITCHING

Type	Boîtier Case	V_{RM} (V)	$I_{R\ max}$ (nA)	V_R (V)	$I_F\ min\ à\ V_F = 1\ V$ (mA)	$C\ à\ 0\ V\ max$ (pF)	$t_{rr\ max}$ (ns)	I_F (mA)
1N 4244	DO-7	15	100	10	20	0,8	0,75	10

E-HAUTE TENSION - COMMUTATION

HIGH VOLTAGE - HIGH SPEED

Type	Boîtier Case	V_{RM} (V)	$I_{R\ max}$ (nA)	V_R (V)	$I_F\ min\ à\ V_F = 1\ V$ (mA)	$C\ à\ 0\ V\ max$ (pF)	$t_{rr\ max}$ (ns)	I_F (mA)
SF.D 86	DO-7	150	10	150	50	6	75	30
1N 3070	DO-7	200	100	200	100	5	50	30

F-DIODES A FAIBLE COURANT DE FUITE

DIODES WITH LOW REVERSE CURRENT

Type	Boîtier Case	V_{RM} (V)	$I_{R\ max}$ (nA)	V_R (V)	$I_F\ min\ à\ V_F = 1\ V$ (mA)	$C\ à\ 0\ V\ max$ (pF)	$t_{rr\ max}$ (ns)	I_F (mA)
1N 3595	DO-7	150	1	125	200	8		

G-DIODES CERATAB

CERATAB DIODES

Type	Boîtier Case	V_{RM} (V)	$I_{R\ max}$ (nA)	V_R (V)	$I_F\ min\ à\ V_F = 1\ V$ (mA)	$C\ à\ 0\ V\ max$ (pF)	$t_{rr\ max}$ (ns)	I_F (mA)
DB 914	DB	100	25	20	10	4	4	10

DIODES DE SIGNAL ET COMMUTATION_DIVERSES DETECTION AND SWITCHING DIODES - MISCELLANEOUS

IV MODULATEURS EN ANNEAU RING MODULATORS

			Caractéristiques générales General Characteristics	
Type	Boîtier Case	Nature	Affaiblissement du courant porteur (min) Carrier voltage attenuation (min) (Np)	Affaiblissement du courant modulateur (min) Modulating voltage attenuation (min) (Np)
A 502 GE	DM-1	Ge	5	6,2
A 503 GE	DM-2	Ge	5	6,2
A 504 GE	DM-1	Ge	4,5	6,2
SF.A 301	DM-1	Si	5	6,2

V MONTAGES REDRESSEURS FAIBLE PUISSANCE LOW POWER RECTIFIER STACKS

			Limites absolues Maximum Ratings $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$	Caractéristiques générales General Characteristics	
Type	Boîtier Case	Nature	$V_{eff} (V_{rms})$ appl. (V)	$t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ (A)	I_0 $t_{amb} = 55^{\circ}\text{C}$ (A)
SF.M 104	DM-1	Ge	35	0,04	0,02
SF.M 106	DM-1	Ge	45	0,03	0,015

VI PHOTODIODES PHOTODIODES

Type	Nature	V_R max (V)	I_R max (mA)	Caractéristiques générales General Characteristics
PHG1	Ge	30	4	$S = 100 \mu\text{A}/1000 \text{ Lux}$ $I_R = 10 \mu\text{A} \text{ à } 0 \text{ Lux}$ Turn on $6 \mu\text{s}$ max
PHG2	Ge	30	4	$S = 50 \mu\text{A}/1000 \text{ Lux}$ $I_R = 10 \mu\text{A} \text{ à } 0 \text{ Lux}$ Turn on $6 \mu\text{s}$ max

VII DIODES DE REDRESSEMENT AU GERMANIUM GERMANIUM RECTIFIERS

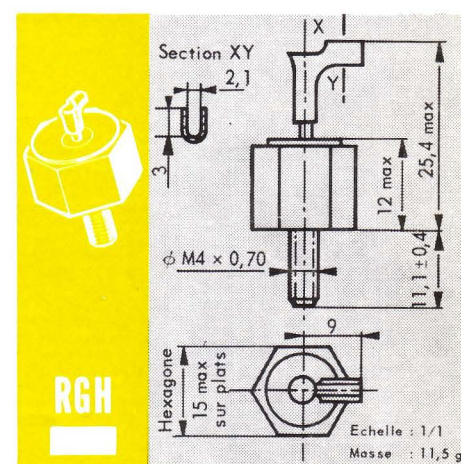
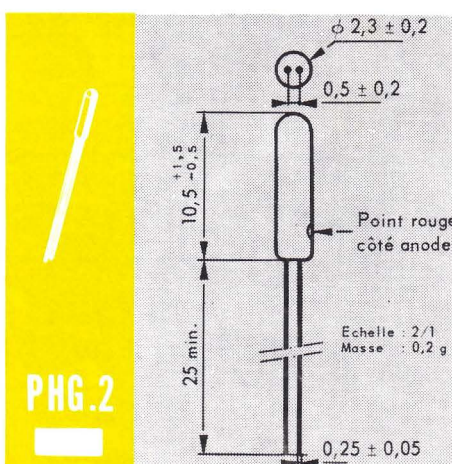
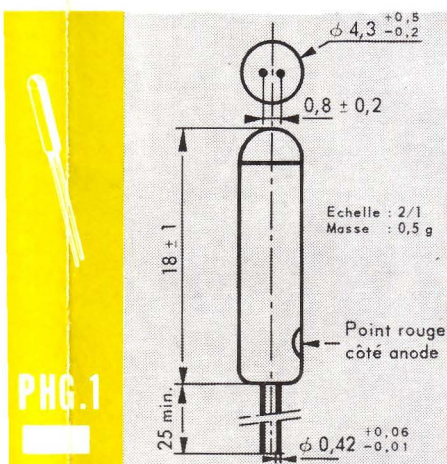
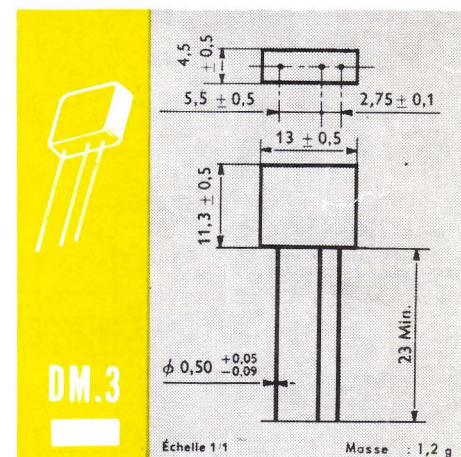
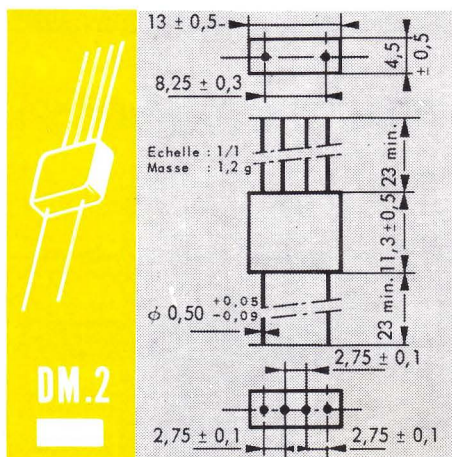
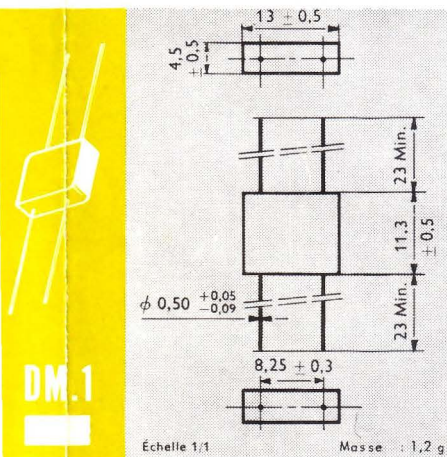
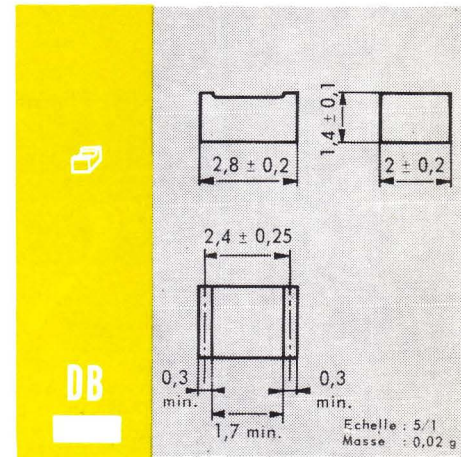
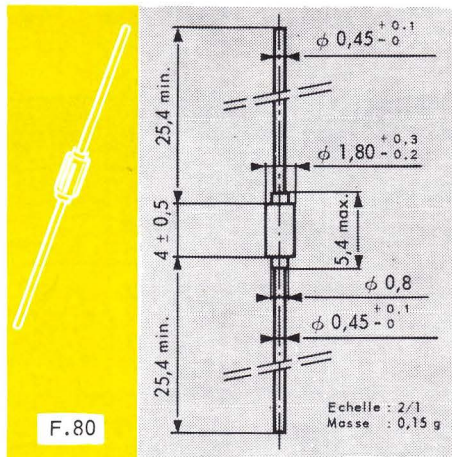
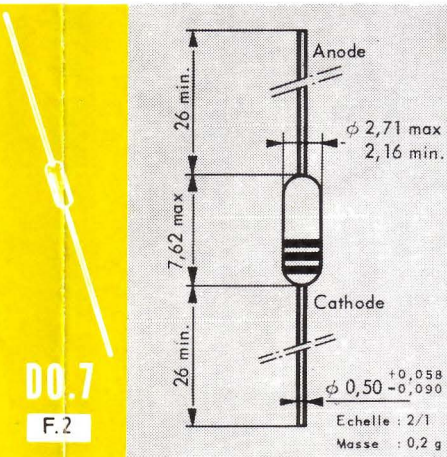
Type	Boîtiers Case	Limites absolues Maximum Ratings			Caractéristiques générales General Characteristics	
		V_{RM} (V)	I_{FM} (A)	I_{FS} (A)	$t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ (A)	I_0 $t_{amb} = 55^{\circ}\text{C}$ (A)
SF.R 135	RGH	100	15	120	6,5 *	2,5 *
SF.R 136	RGH	50	15	120	7 *	3 *

* Boîtiers sur AILETTES de 70 cm^2 .

VIII MONTAGES DIVERS

La COSEM est en mesure de fabriquer en série de nombreux moulages modulaires de diodes nues ou de jonctions.

Pour tous renseignements, nous consulter.



Toutes dimensions en mm - Dimensions in mm
F. Références SITELESC - CCTU